Формат	Зона	Π 03.	Обозн	ачение		Наименование		Кол.	Примечание
						Документация	<u>.</u>		
*			ИЯДС.121.	212.122	ПЭ3	Перечень элементов			AAA
A3			ИЯДС.121.	212.122	ПЭ3	Перечень элементов			
A 3			ИЯДС.121.	212.122	ПЭ3	Перечень элементов			
						<u>Комплексы</u>			
			1	11		11		1	
			1	11		11		1	
						Сборочные едини	щы		
A2		1	ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2		2	ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2			ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2		3	ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2		4	иядс.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2			ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
						<u>Детали</u>			
A2		10	иядс.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2			ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
		11				Ловитель		2	XT3,XT4
						СТИК.741532.035			НИИАО
						3		<u> </u>	<u> </u>
Изм Раз _І	_	_	№ докум. Подп.	Дата			Лит.	Лист	Листов
Πpo		7				1	2 3 4	1	??
Н. к Утв		p. 9 0			спе	цификация			

Подп. и дата

Взам. инв. $N^{\underline{o}} \mid H$ нв. $N^{\underline{o}} \neq Jy6$ л.

Подп. и дата

Mнв. N $^{\underline{0}}$ подл.

	Формат	Зона	Поз.	Обоз	вначение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
						Стандартные изделия			
			17			ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
						элементов			
						ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
						элементов			
			18			ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
						элементов			
			19			Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT1	
						ΓΟCT 16840-78			
						SSSSSSSSSSSSSSS			
			20			Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT2	
						ΓΟCT 16840-78			
			21			Резистор чип CRCW04020000Z	1	R142*	
						(0 Ом, 50В)		Vishay	,
m						Прочие изделия			
и дата									
Подп. и д									
Ϊ						<u> Конденсаторы</u>			
ол.									
Инв. № дубл.			32			Конденсатор чип	8	C5, C6	ı
Інв. Л						C0805C105K4RAC (C9-C1	2, C14,
						1 мкФ, 16В)		C15	
Взам. инв. №								Ke m e t	
зам. 1			33			Конденсатор танталовый чип	2	C7,C8	
B						T491C107K010AT (100 мкФ)		Kemet	
та			34			Конденсатор чип	1	C13	
л де						C0805C105K4RAC1 (Kemet	
Подп. и дата									
<i>t</i> 71.									
Инв. № подл.	\vdash		<u> </u>	ı	<u> </u>				П
IHB. J						3			<i>Лист</i> 2
I.	Изм	π_{ν}	ICT	№ докум. Подп.	Дата	Vониторо и		Форг	

	Формат	Зона	Π_{O3} .		Обозн	ачение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
							1 мкФ, 16В)			
							Микросхемы			
			40				Микросхема SN74AHC1G125DCK	2	DD1,L	DD2
									Texas	Instr.
							<u>Резисторы</u>			
			46				Резистор чип CRCW06032K20JN	12	R5,R1	1,
							(Корпус ddd , 43 , 23 ,		R14-R	16,
							2,2 кОм, 75В)		R19,R	21,
									R50,R	64,
									R100,I	R102,
									R108	
									Vishay	,
<i>[a</i>			47				Резистор чип CRCW0603220RJN	10	R9,R1	0,R18,
Подп. и дата							(220 Ом, 75В)		R98,R	99,
Годи.									R111,1	R113,
									R115,I	R126,
6л.									R128	
№ ДУ									Vishay	7
Инв. № дубл.			48				Резистор чип CRCW060361R9FK	1	R13	
							(61,9 Ом, 75В)		Vishay	7
инв.			49				Резистор чип CRCW06030000Z0	6	R17,R	20,
B зам. инв. N $^{ ilde{ ii}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}} }}}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}} }} }} }} }} }} }} }} }} }}}}$							(0 Ом, 75В)		R46,R	
H									R104,I	R107
цата									Vishay	,
Подп. и дата			50				Резистор чип CRCW04020000Z0	56	R23-R	30,
Щош										
подл.										
Инв. № подл.			\blacksquare				3			Лист
Ит	Изм	Ли	СТ	№ докум.	Подп.	Дата	Vogamone a		Форг	3

	Формат	Зона	Поз.		Обозн	ачение	,	Наименование	Кол.	Приме	ечание
								(0 Om, 50B)		R32-R	37,
										R44,R4	45,
										R47,R4	48,
										R52-R	63,
										R66-R	77,
										R92-R	97,
										R116-I	R119,
										R121-I	R124
										Vishay	r
								<u>Диоды</u>			
			56					Диод BAV23 (200B)	1	VD1	
										NXP	
								<u>Соединители</u>			
ľa											
и дал			62					Вилка 53398-1071	6	XP1-X	<i>IP6</i>
Подп. и дата										Molex	
			63					Вилка	1	XP7	
6л.								QMS-078-02-SL-D-RA-MG		Samte	c
Инв. № дубл.			64					Розетка VJ779-10006	5	XS1,X	S2,
Инв.								Допуск (VJ773-10001)		XS3,X	S4,
										XS8	
инв.										Amphe	enol
Взам. инв. №			65					Вилка 83612-9020	1	XS5	
										Molex	
ата			66					Розетка 280-027S5S50MTNA	1	XS6	
Подп. и дата										Glenai	r
Подп											
идл.	-										
Инв. № подл.			$\overline{}$								Лист
Инв.	11		105	Ma	Π	TT		3			4
	Изм	JIV	1CT	№ докум.	Подп.	Дата					

	Φ ормат	Зона	Поз.	Обозна	чение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
			67			Розетка MUSB-C111-M0	1	XS7	
								Amph	enol
			68			Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT1	
						ΓΟCT 16840-78			
						SSSSSSSSSSSSSSS			
			69			Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT2	
						ΓΟCT 16840-78			
			70			Ловитель	2	XT3,X	KT4
						СТИК.741532.035		НИИА	10
			71			Кабель	2	X1,X2	•
						FFMD-05-T-02.00-01-N		Samte	\overline{c}
						Элементы не устанавливать			
						<u>Конденсаторы</u>			
			77			Конденсатор чип ААААААААААА	1	C1*	
						GR442QR73D102KW01 (Murat	a
						1000 п Φ , +/-56%, 2000B)		ghdbjc	dgb
						Допуск (ААААААААА)			
			78			Конденсатор чип	3	C2*-C	4*
						GR442QR73D102KW01 (Murat	a
_						1000 пФ, 2000В)			
			32			Конденсатор чип	1	C16*	
						C0805C105K4RAC		Kemet	ţ
						(Корпус DDDDDD ,			
						1 мкФ, 16B) Ту 45476587-90			
			34			Конденсатор чип	1	C17*	
						3			Лист
. L		1	1						

	Φ ормат	Зона	Π_{O3} .		Обозна	ачение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
							C0805C105K4RAC1		Kemet	
							(Корпус DDDDDD ,			
							1 мкФ, 16B) Ту 45476587-90			
			79				Конденсатор чип	1	C18*	
							C0805C105K4RAC2		Kemet	
							(Корпус DDDDD , 1 мк Φ , 16В)			
							Ty 45476587-90			
			80				Конденсатор чип	1	C19*	
							C0805C105K4RAC3		Kemet	
							(Корпус DDDD , 1 мкФ, 16B)			
							Ty 45476587-90			
			81				Конденсатор чип	1	C20*	
							C0805C105K4RAC4		Kemet	
							(Корпус DDD , 1 мкФ, 16B)			
							Ty 45476587-90			
			82				Конденсатор чип	1	C21*	
g.							C0805C105K4RAC5		Keme	
и дата							(Корпус DDDDDD ,			
Подп. и							1 мкФ, 16B) Ту 45476587-90			
Инв. № дубл.							<u>Резисторы</u>			
нв. №			46				Резистор чип CRCW06032K20JN	7	R1*-R	4 *,
$\mathcal{N}_{ar{\varrho}}$ M							(2,2 кОм, 75В)		R6*-R	8*
									Vishay	,
Взам. инв.			48				Резистор чип CRCW060361R9FK	1	R12*	
B:							(61,9 Ом, 75В)		Vishay	,
дата			49				Резистор чип CRCW06030000Z0	12	R22*,I	R31*,
. и да							(0 Ом, 75В)		R40*,I	R43*,
подл. Подп. и							•			
Инв. № подл.							9			Лист
Ин	Изм	Ли	cT	№ докум.	Подп.	Дата	3			6

	Φ ормат	Зона	Поз.		Обозн	ачение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
									R51*,I	R65*,
									R101*	,R103*
									R105*	,R106*
									R109*	,R120*
									Vishay	7
			50				Резистор чип CRCW04020000Z0	33	R38*,I	R39*,
							(0 Om, 50B)		R41*,I	R42*,
									R 78*-1	R91*,
									R129*	-R141*
									R143*	,R144*
									Vishay	,
			47				Резистор чип CRCW0603220RJN	5	R110*	,R112*
							(220 Ом, 75В)		R114*	,R125*
									R127*	
									Vishay	,
			88				Резистор чип CRCW04020000Z	1	R142*	
(aTa							(0 Ом, 50В)		Vishay	,
и даз										
Подп. и д							<u>Соединители</u>			
л.			64				Розетка VJ779-10006	1	XS3*	
Инв. № дубл.									Amph	enol
			99				ИЯДС.121212.122 Сб Сборочный	9		
Взам. инв. №			00				чертеж Сборочный чертеж			
М. ИЕ							Сборочный чертеж Сборочный			
Вза							чертеж Сборочный чертеж			
я							Сборочный чертеж			
и дат							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
цл. Подп. и дата							1117, 61121221122 1133 116pc 16.115	1		
Инв. № подл.										Лист
Инв	T.F		1	N.C.	T.	TT	3			лист 7
· ¬	Изм	JIV	1CT	№ докум.	Π одп.	Дата	Volumone v			' 10m A A

	гат	a	.:					ر ا		
	Формат	Зона	Π_{O3} .		Обозн	ачение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
							элементов			
							<u>Материалы</u>			
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7	CM	
							элементов			
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7	CM	
							элементов			
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7	CM	
							элементов			
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7	CM	
							элементов			
							<u>Комплекты</u>			
•						1	1	1		
a										
и дал										
Подп. и дата										
Ш										
бл.										
№ ДУ										
Инв. № дубл.										
инв.										
Взам. инв. №										
E										
ата										
г. и д										
Подп. и дата										
тодл.										
Инв. № подл.							9			Лист
Инп	Изм	Ли	ICТ	№ докум.	Подп.	Дата	3			8

		Hor	иера лист	OR (crns	Лис нип) Т	т регистрации и	зменений 	Входящий №		
	Изм.	изме-	заме- ненных	новых	аннули- рован- ных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	сопроводитель- ного докум. и дата	Подп.	Дата
_										
			<u> </u>	<u> </u>			I			
_	1	Γ	<u> </u>							J